

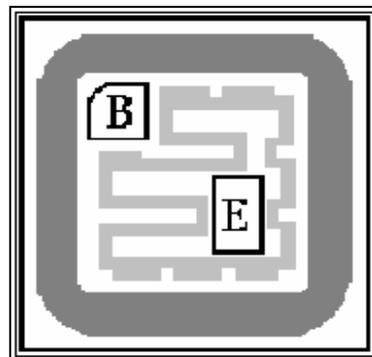


13001 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D083AJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：830×830μm²
 焊位尺寸：B 极 140×144μm²，E 极 180×140μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：KSE13001，HE13001

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....900mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....600V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....400V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....9V
 I_C——集电极电流 (DC).....0.25A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA，I _B =0
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	600			V	I _C =1mA，I _E =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	I _E =1mA，I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	V _{CB} =500V，I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	V _{EB} =9V，I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	8		70		V _{CE} =10V，I _C =20mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			0.6	V	I _C =100mA，I _B =20mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.2	V	I _C =100mA，I _B =20mA
f _T	特征频率	8			MHz	V _{CE} =10V，I _C =20mA